

МОЩНЫЕ РАДИАЦИОННОСТОЙКИЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 2П7160 В МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРПУСАХ

Мощные радиационностойкие кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с изолированным затвором и n-каналом, встроенным диодом в металлокерамических корпусах с изолированным (беспотенциальным) фланцем и планарными выводами транзисторы 2П7160 АЕЯР.432140.374ТУ/Д1 предназначены для работы во вторичных источниках электропитания, импульсных модуляторах в качестве силовых транзисторных ключей и в другом электрооборудовании изделий специального назначения.

Категория качества транзисторов – «ВП» (приемка «5»).

Наличие беспотенциального основания позволяет исключить необходимость электроизоляционных прокладок при установке на теплоотвод (радиатор). Приборы без крепежного отверстия пригодны для SMD сборки.

Транзисторы изготавливают одного типа двадцати трех типонаименований.

В зависимости от типонаименования возможны три варианта исполнения без металлизации обратной стороны корпуса:

- вариант исполнения в корпусах типа КТ-111А,В,С-1.02 с крепежным отверстием во фланце;
- вариант исполнения в корпусах типа КТ-111А,В,С-2.02 без крепежного отверстия во фланце;
- вариант исполнения в корпусах типа КТ-111С-5 без крепежного отверстия во фланце.

Масса транзистора в корпусе КТ-111А-1.02 – 2,0 г, КТ-111В-1.02 – 3,4 г, КТ-111С-1.02 – 4,1 г, КТ-111А-2.02 – 1,8 г, КТ-111В-2.02 – 3,1 г, КТ-111С-2.02 – 3,6 г, КТ-111С5 – 4,5 г.

Наименование изделия	Тип корпуса	Макс. допустимые параметры					Основные электрические параметры		
		$U_{СИ\ max},$ В	$U_{ЗИ\ max}$ В	$I_{C\ max},$ А	$I_{C(И)\ max},$ А	$P_{C\ max},$ Вт	$R_{СИ\ отк},$ Ом	$U_{ЗИ\ пор},$ В	$\tau_{сп},$ мкс
2П7160А2 2П7160А3•	КТ-111С-1.02 КТ-111С-2.02	30	20	46	70	125	0,006 ($I_c=20A, U_{зи}=12B$)	2-4	$\leq 0,15$
2П7160Б2 2П7160Б3•	КТ-111А-1.02 КТ-111А-2.02	100	20	20	50	75	0,048 ($I_c=15A, U_{зи}=10B$)	2-4	$\leq 0,12$
2П7160В2 2П7160В3•	КТ-111В-1.02 КТ-111В-2.02	200	20	35	70	125	0,080 ($I_c=12A, U_{зи}=10B$)	2-4	$\leq 0,15$
2П7160Г2 2П7160Г3•	КТ-111С-1.02 КТ-111С-2.02	400	20	23	46	150	0,200 ($I_c=10A, U_{зи}=10B$)	2-4	$\leq 0,15$
2П7160Д2 2П7160Д3•	КТ-111С-1.02 КТ-111С-2.02	500	20	20	46	150	0,230 ($I_c=10A, U_{зи}=10B$)	2-4	$\leq 0,15$
2П7160Е2 2П7160Е3•	КТ-111В-1.02 КТ-111В-2.02	60	20	35	70	150	0,008 ($I_c=15A, U_{зи}=10B$)	2-4	$\leq 0,15$
2П7160Ж2 2П7160Ж3•	КТ-111А-1.02 КТ-111А-2.02	100	20	20	50	100	0,036 ($I_c=15A, U_{зи}=10B$)	2-4	$\leq 0,13$
2П7160И2 2П7160И3•	КТ-111С-1.02 КТ-111С-2.02	200	20	35	70	150	0,055 ($I_c=12A, U_{зи}=10B$)	2-4	$\leq 0,15$

2П7160К2 2П7160К3•	КТ-111С-1.02 КТ-111С-2.02	600	20	20	46	150	0,270 ($I_C=10A, U_{ЗИ}=10B$)	2-4	$\leq 0,15$
2П7160Л3	КТ-111С-5	1200	20	10	25	200	1,00 ($I_C = 5 A, U_{ЗИ} = 15 B$)	2-4	$\leq 0,15$
2П7160М3	КТ-111С-5	600	20	20	60	180	0,15 ($I_C = 10 A, U_{ЗИ} = 15 B$)	2-4	$\leq 0,15$
2П7160Н3	КТ-111С-5	100	20	50	150	150	0,01 ($I_C = 25 A, U_{ЗИ} = 15 B$)	2-4	$\leq 0,10$
2П7160П3	КТ-111С-5	60	20	50	150	150	0,005 ($I_C = 30 A, U_{ЗИ} = 15 B$)	2-4	$\leq 0,10$
2П7160Р2 2П7160Р3	КТ-111А-1.02 КТ-111А-2.02	30	20	20	50	100	0,008 ($I_C = 10 A, U_{ЗИ} = 10 B$)	2-4	$\leq 0,15$